

浙江省2009年7月高等教育自学考试线性电子电路试题自考
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_B5_99_E6_B1_9F_E7_9C_812_c67_645828.htm 浙江省2009年7月高等教育

自学考试 线性电子电路试题 课程代码：02340一、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。1.在P型半导体中，导电时以_____为主。2.在杂质半导体中，多数载流子的浓度主要取决于_____。3.晶体三极管工作在放大区时， $I_C = \beta I_B$ 。4.晶体三极管具有放大作用的外部条件是发射结正向偏置和_____结反向偏置。5.场效应管工作在非饱和区时，其 I_D 和 V_{DS} 之间呈_____关系。6.通常将开始形成反型层所需的 V_{GS} 值称为_____电压。7.三种晶体三极管基本组态放大电路中，_____组态输入电阻最小。百考试题自考站，你的自考专家！8.已知某晶体三极管的高频参数 f_T 、 β ，则共基截止频率 f_c 约为_____。9.需要一个阻抗变换电路，其输入电阻小，应引入_____负反馈电路。10.为充分提高负反馈的效果，串联负反馈要求信号源内阻_____。

二、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1.半导体中的载流子是指() A.自由电子 B.空穴 C.离子 D.自由电子和空穴

2.稳压二极管在稳压状态时，它的PN结处在_____状态。() A.反向截止 B.反向击穿 C.正向导通 D.零偏

3.测得三极管 $I_B = 30 \mu A$ 时， $I_C = 2.4 mA$ ，而 $I_B = 40 \mu A$ 时， $I_C = 3 mA$ ，则该管的交流电流放大倍数为() A.80 B.60 C.75 D.100

4.晶体三极

管的输出特性曲线分为四个区，请问哪个区具有基区宽度调制效应？（ ） A.饱和区 B.截止区 C.放大区 D.击穿区

5.根据场效应管的转移特性，可知场效应管是一种_____器件。（ ） A.电压控制电压源 B.电流控制电压源 C.电压控制电流源 D.电流控制电流源

6.某场效应管的 I_{DSS} 为6mA，而 I_{DQ} 自源极流出，大小为8mA，则该管是（ ） A.P沟道耗尽型MOS管 B.N沟道耗尽型MOS管 C.P沟道增强型MOS管 D.N沟道增强型MOS管

7.共集电极放大电路的特点之一是（ ） A.输入电阻高 B.电压增益大 C.输入输出反相 D.输出电阻高

8.集成运算放大器实质上是一种（ ） A.交流放大器 B.高增益的交流放大器 C.高增益的直接耦合放大器 D.高增益的高频放大器

9.负反馈可以改善放大器的性能，问关于放大器下述哪种说法不正确？（ ） A.减少放大器的增益 B.改变输入电阻 C.改变输出电阻 D.改善信号源的噪声系数

10.某放大电路的电压增益为40dB，而加入负反馈后变为6dB，它的反馈深度F为（ ） A.30dB B.34dB C.46dB D.50dB

11.温度增加时，在 I_D 不变的情况下，晶体二极管的 $V_D(on)$ 将（ ） A.增大 B.减小 C.不变 D.未知

12.已知某晶体三极管的 $\beta = 99$ ，则该管的共基电流放大系数为（ ） A.1.00 B.0.995 C.0.99 D.0.985

13.当场效应管的 V_{GS} A.饱和区 B.非饱和区 C.击穿区 D.截止区

14.要求晶体管工作在放大区，若是NPN晶体管，则三个电极电位 V_B 、 V_E 、 V_C 之间应满足何种关系？（ ） A. $V_C > V_B > V_E$

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com